

第一章概 要

1-1 概 要

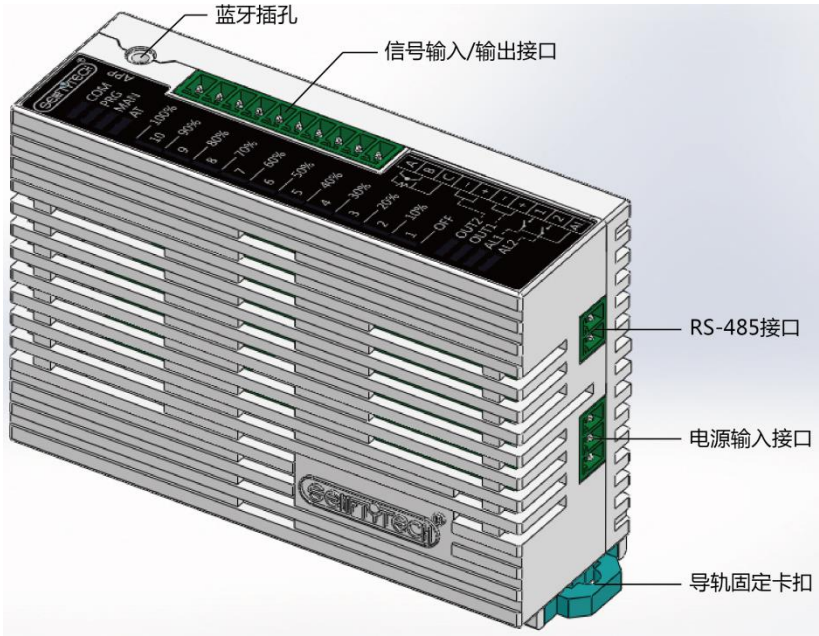
本產品具有如下特點

- 體積小，外形尺寸 90mmx30mmx63.5mm，導軌式安裝，節省空間。
- 各種狀態指示燈，具有良好的監視性。
- 輸入種類有熱電偶（K、J、T、R、E、S、B、N）、熱電阻（Pt100、JPt100）、電流信號（DC4~20mA、DC0~20mA）、電壓信號（DC0~10mV、DC-10~+10mV、DC0~100mV、DC0~1V、DC1~5V、DC0~5V、DC0~10V）。
- 實現了精度為±0.2%，採樣週期 0.1s 的高精度。
- 控制輸出種類有繼電器輸出、SSR 驅動用電壓脈衝輸出、線性電流輸出、線性電壓輸出。控制輸出 1 與 2 可以組合使用。
- 2 路報警觸點輸出。
- 控制方式 ON/OFF 控制、固定 PID 控制。
- 通訊介面有藍牙插孔、RS-485 介面。藍牙介面可與手機 APP 連接進行監控和參數設置。

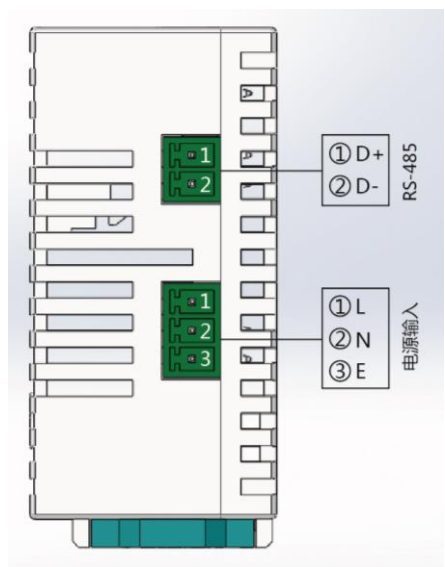
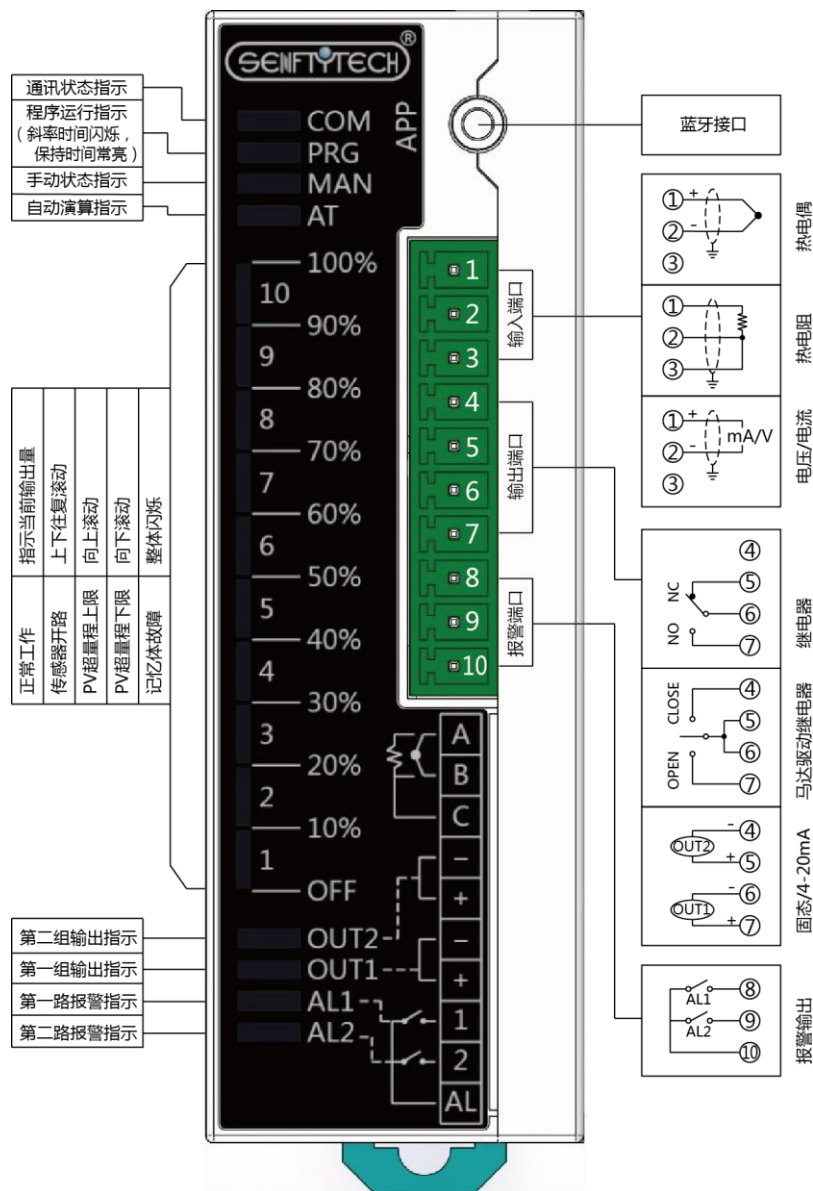
型號構成

1-2 各部的名稱及功能

- 各部件功能



● 面板指示燈詳解及接線圖



各功能詳解

■PV 量程種類

熱電偶及熱電阻の場合，可選擇感測器類型及溫度量程。直流電壓・直流電流の場合可選擇信號の種類。

階層	顯示	內容	初始值	RAM 地址	EEPROM 地址
INP	INP1	PV 量程種類（表 1）	1		

表 1：PV 量程種類

INP 設定値	顯示代碼	感測器類型	℃ 量程	°F 量程
0	K1	K	0～200	32～392
1	K2	K	0～400	32～752
2	K3	K	0～800	32～1472
3	K4	K	0～1000	32～1832
4	K5	K	0～1200	32～2192
5	J1	J	0～200	32～392
6	J2	J	0～400	32～752
7	J3	J	0～800	32～1472
8	J4	J	0～1000	32～1832
9	J5	J	0～1200	32～2192
10	T1	T	-50～50	-58～122
11	T2	T	-100～100	-148～212
12	T3	T	-200～400	-328～752
13	R	R	0～1700	32～3092
14	E	E	0～1000	32～1832
15	S	S	0～1700	32～3092
16	B	B	0～1800	32～3272
17	N	N	-200～1300	-328～2372
18	Pt1	Pt100	-50～50	-58～122
19	Pt2	Pt100	0～100	32～212
20	Pt3	Pt100	0～200	32～392
21	Pt4	Pt100	0～400	32～752
22	Pt5	Pt100	-200～600	-328～1112
23	JPt	JPt100	-200～500	-328～932
24	10mV	0～10mV	-1999～+9999 範圍可設定， 小數點位置可變	
25	-10.10	-10mV～10mV		
26	100m	0～100mV		
27	0-1V	0～1V		
28	1-5V	1～5V		
29	0-5V	0～5V		
30	10V	0～10V		
31	0-20	0～20mA		
32	4-20	4～20mA		

■溫度單位

PV 量程種類為熱電偶或熱電阻的場合，可選擇溫度單位。

階層	顯示	內容	初始值	RAM 地址	EEPROM 地址
INP	UNIT	0：攝氏℃ 1：華氏°F	0		

■小數點位置

PV 量程種類為直流電壓·直流電流的場合或熱電偶、熱電阻的一部分 PV 量程種類的場合，可設定 PV 輸入的小數點位置。

階層	顯示	內容	初始值	RAM 地址	EEPROM 地址
INP	DP	0：無小數點 1：小數點以下 1 位 2：小數點以下 2 位 3：小數點以下 3 位	0		

■PV 量程下限·上限

階層	顯示	內容	初始值	RAM 地址	EEPROM 地址
INP	LOSP	PV 量程為熱電偶、熱電阻的場合，是 PV 量程種類的上限值、下限值；PV 量程為直流電壓·直流電流的場合-1999~9999，小數點位置由 DP 決定	0.0		
	HISP		400.0		

■PV 比率與 PV 偏置

為了進行 PV 補正，可設定 PV 比率與 PV 偏置

階層	顯示	內容	初始值	RAM 地址	EEPROM 地址
INP	PVOF	-199.9~200.0	0.0		
	PVRR	0.001~9.999	1.000		

PV 比率、PV 偏置運算詳解

運算輸入用 PVin 表示，運算結果用 PVout 表示，則其關係為： $PVout = (PVin \times PVRR) + PVOF$

■PV 濾波

階層	顯示	內容	初始值	RAM 地址	EEPROM 地址
INP	FILT		0.6		

表 2：報警功能選擇

0		無報警
1		偏差上限
2		偏差下限

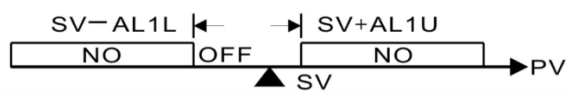
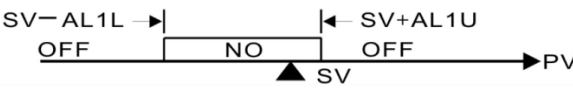
3		絕對上限
4		絕對下限
5		偏差上下限
6		偏差範圍內
7	系統異常報警	
8	加熱器斷線報警	
9	程式控制段結束(程式控制專用)	
10	程式控制結束(程式控制專用)	
11	程式執行中(程式控制專用)	
12	程式暫停中(程式控制專用)	

表 3：報警特殊功能設定

0	無特殊功能
1	無特殊功能(b 接點動作)
2	動作後不復歸
3	動作後不復歸(b 接點動作)
4	待機(上電第一次不動作)
5	待機(b 接點動作)
6	待機與動作後不復歸
7	待機與動作後不復歸(b 接點動作)
8	計時器延遲動作
9	計時器延遲動作(b 接點動作)
10	計時器持溫動作
11	計時器持溫動作(b 接點動作)

表 4：階層開放說明

LOCK	USER	CNTL	PID	OUT	INP	SPC	PROG	LINE
0	△	×	×	×	×	×	×	×
101	△	×	×	×	×	×	×	×
11	○	×	×	×	×	×	×	×
22	○	○	○	×	×	×	×	×
111	○	○	○	○	×	×	×	×

222	○	○	○	○	○	×	×	×
1100	○	○	○	○	○	○	×	×
2200	○	○	○	○	○	○	○	×
1122	○	○	○	○	○	○	○	○
△=可以顯示但不能設定，LOCK=101 除外，LOCK=101 時 SV 可以調整 ○=可以顯示與設定 ×=不能顯示與設定								

通訊協定

通訊參數

項目	內容	初始值
通訊速率	0：2400bps 1：4800bps 2：9600bps 3：19200bps 4：38400bps	2
儀錶地址	0：不通訊 1～127	1
資料停止位元	0：1 位 1：2 位	0
資料校驗位元	0：無校驗 1：偶校驗 2：奇數同位檢查	0

通訊順序

- 從上位機設備（主機）向要通訊的 1 臺本機（子機）發送電文。
- 子機收到命令電文後，按電文的內容進行讀寫處理。
- 子機按照處理內容反送回應電文。
- 主機接收回應電文。

電文格式

（03H）讀寄存器→請求

0	1	2	3	4	5	6	7
	03H	MSB	LSB	MSB	LSB	LSB	MSB
站地址	命令代碼	寄存器起始位址		寄存器個數		CRC16 校驗碼	

讀寄存器→回應

0	1	2	3	4	5	6	7	8
	03H	數據個數×2	MSB	LSB	MSB	LSB	LSB	MSB
站地址	命令代碼	位元組數	數據 1		數據 2……		CRC16 校驗碼	

(06H) 寫入單個寄存器→請求

0	1	2	3	4	5	6	7
	06H	MSB	LSB	MSB	LSB	LSB	MSB
站地址	命令代碼	寄存器位址		數據		CRC16 校驗碼	

寫入單個寄存器→回應

0	1	2	3	4	5	6	7
	06H	MSB	LSB	MSB	LSB	LSB	MSB
站地址	命令代碼	寄存器位址		數據		CRC16 校驗碼	

(10H) 寫入多個寄存器→請求

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	10H	MSB	LSB	MSB	LSB	個數×2	MSB	LSB	MSB	LSB	LSB	MSB
站地址	命令代碼	寄存器起始位址		寄存器個數		位元組數	數據 1		數據 2……		CRC16 校驗碼	

寫入多個寄存器→響應

0	1	2	3	4	5	6	7
	10H	MSB	LSB	MSB	LSB	LSB	MSB
站地址	命令代碼	寄存器起始位址		寄存器個數		CRC16 校驗碼	

通訊舉例

(03H) 從 01 號站讀取當前 PV 值→請求

0	1	2	3	4	5	6	7
0x01	0x03	0x10	0x00	0x00	0x01	0x80	0xCA
站地址	命令代碼	寄存器起始位址		寄存器個數		CRC16 校驗碼	

當 01 號站 PV 為 100.0 時→回應

0	1	2	3	4	5	6
0x01	0x03	0x02	0x03	0xE8	0xB8	0xFA
站地址	命令代碼	位元組數	數據 1		CRC16 校驗碼	

(06H) 將 01 號站的 SV 設定為 100.0→請求

0	1	2	3	4	5	6	7
0x01	0x06	0x10	0x02	0x03	0xE8	0x2C	0x74
站地址	命令代碼	寄存器位址		數據		CRC16 校驗碼	

寫入成功後 01 號站→回應

0	1	2	3	4	5	6	7
0x01	0x06	0x10	0x02	0x03	0xE8	0x2C	0x74
站地址	命令代碼	寄存器位址		數據		CRC16 校驗碼	

(10H) 將 01 號站的 P1 改為 3.0，I1 改為 240，D1 改為 60→請求

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

0x01	0x10	0x50	0x4B	0x00	0x03	0x06	0x00	0x1E	0x00	0xF0	0x00	0x3C	0x3C	0x90
站地址	命令代碼	寄存器起始位址		寄存器個數		位元組數	數據 1		數據 2		數據 3		CRC16 校驗碼	

寫入成功後 01 號站→回應

0	1	2	3	4	5	6	7
0x01	0x10	0x50	0x4B	0x00	0x03	0xE1	0x1E
站地址	命令代碼	寄存器起始位址		寄存器個數		CRC16 校驗碼	

資料位址的定義

資料位址的 RAM/EEPROM 領域資料位址按如下分類。

資料位址（16 進制）	名稱	備註
1000H~10D2H	控制參數的 RAM 資料位址	讀/寫均訪問 RAM 領域的資料，而不向 EEPROM 寫入，再次投入電源後，將回到 EEPROM 記憶的值
1100H~11FFH	程式曲線的 RAM 資料位址	
5000H~50D2H	控制參數的 EEPROM 資料位址	讀/寫均訪問 EEPROM 領域的資料，並向 EEPROM 寫入，即使重新投入電源，值也不變
5100H~51FFH	程式曲線的 EEPROM 資料位址	

使用上的注意

EEPROM 的寫入次數有限制，約 100 萬次。

所以對修改頻率非常大的參數，建議寫入到沒有寫入限制的 RAM 中，單執行 RAM 寫入後，當電源再投入時，EEPROM 的資料被傳送。

階層	項目	參數	RAM 地址	EEPROM 地址	讀寫
USER	PV：測量值	目前測量值	1000H	5000H	唯讀
	LOCK：階層密碼	0-9999（參照表 4）	1001H	5001H	讀/寫
	SV：目標值	參照表 1	1002H	5002H	讀/寫
	OUTL：當前輸出量	0.0~100.0%	1003H	5003H	讀/寫

用戶階層	AT：自動演算	0=NO，1=YES	1004H	5004H	讀/寫
	MAN：手動模式	0=NO，1=YES 記憶，2=YES 不記憶	1005H	5005H	讀/寫
	AL1S：第一組報警設定值	AL1F=1、2 範圍=-199.9~200.0 AL1F=3、4 範圍=LOSP~HISP	1006H	5006H	讀/寫
	AL1L：第一組報警低點設定值	0~200.0	1007H	5007H	讀/寫
	AL1U：第一組報警高點設定值	0~200.0	1008H	5008H	讀/寫
	AL2S：第二組報警設定值	AL2F=1、2 範圍=-199.9~200.0 AL2F=3、4 範圍=LOSP~HISP	1009H	5009H	讀/寫
	AL2L：第二組報警低點設定值	0~200.0	100AH	500AH	讀/寫
	AL2U：第二組報警高點設定值	0~200.0	100BH	500BH	讀/寫
	AL3S：第三組報警設定值	AL3F=1、2 範圍=-199.9~200.0 AL3F=3、4 範圍=LOSP~HISP	100CH	500CH	讀/寫
	AL3L：第三組報警低點設定值	0~200.0	100DH	500DH	讀/寫
	AL3U：第三組報警高點設定值	0~200.0	100EH	500EH	讀/寫
	SOAK：持溫時間設定	00.00~99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	100FH	500FH	讀/寫
	RPTM：程式重複次數顯示	1~1000	1010H	5010H	唯讀
	預留		1011H	5011H	
	預留		1012H	5012H	
	預留		1013H	5013H	

階層	項目	參數	RAM 地址	EEPROM 地址	讀寫
C N T L	CTR1：輸出一控制模式	0=ON/OFF，1=PID	1014H	5014H	讀/寫
	CT1：輸出一控制週期	0~150 秒，0=類比信號輸出	1015H	5015H	讀/寫
	HST1：輸出一 ON/OFF 不感帶	0.0~200.0	1016H	5016H	讀/寫
	CTR2：輸出二控制模式	0=ON/OFF，1=PID	1017H	5017H	讀/寫

控制 階 層	CT2：輸出二控制週期	0～150 秒，0=類比信號輸出	1018H	5018H	讀/寫
	HST2：輸出二 ON/OFF 不感帶	0.0～200.0	1019H	5019H	讀/寫
	ATTY：自動演算模式	0=通常，1=快速，2=穩定	101AH	501AH	讀/寫
	ATOL：自動演算輸出下限	0.0～100.0%	101BH	501BH	讀/寫
	ATOH：自動演算輸出上限	0.0～100.0%	101CH	501CH	讀/寫
	RAMP：斜率控制單位	0=0.0/秒，1=0.1/分，2=0.1/時	101DH	501DH	讀/寫
	SPU：斜坡上升斜率	0.0～999.9，0=關閉	101EH	501EH	讀/寫
	SPD：斜坡下降斜率	0.0～999.9，0=關閉	101FH	501FH	讀/寫
	DB：雙輸出間隙	-200.0～200.0	1020H	5020H	讀/寫
	RUMD：馬達閥模式	0=馬達閥（開環），1=比例閥（閉環）	1021H	5021H	讀/寫
	RU-C：比例閥全關值	0～9999	1022H	5022H	讀/寫
	RU-O：比例閥全開值	0～9999	1023H	5023H	讀/寫
	RUIDB：閥動作不感帶	0.5%～25.0%	1024H	5024H	讀/寫
	RUCY：馬達閥運轉時間	5.0～240.0 秒	1025H	5025H	讀/寫
	預留		1026H	5026H	

階 層	項目	參數	RAM 地址	EEPROM 地址	讀寫
O U T 輸 出 階 層	AL1F：第一組報警功能設定	參照表 2	1027H	5027H	讀/寫
	AL1H：第一組報警不感帶設定	0.0～200.0	1028H	5028H	讀/寫
	AL1M：第一組報警模式設定	0～11（參照表 3）	1029H	5029H	讀/寫
	AL2F：第二組報警功能設定	參照表 2	102AH	502AH	讀/寫
	AL2H：第二組報警不感帶設定	0.0～200.0	102BH	502BH	讀/寫
	AL2M：第二組報警模式設定	0～7（參照表 3）	102CH	502CH	讀/寫
	AL3F：第三組報警功能設定	參照表 2	102DH	502DH	讀/寫
	AL3H：第三組報警不感帶設定	0.0～200.0	102EH	502EH	讀/寫
	AL3M：第三組報警模式設定	0～7（參照表 3）	102FH	502FH	讀/寫
	ACT：第一組輸出動作模式	0=逆動作（冷卻），1=加熱	1030H	5030H	讀/寫
	O1LS：第一組輸出低點調整	0.0～100.0%	1031H	5031H	讀/寫
	O1HS：第一組輸出高點調整	0.0～100.0%	1032H	5032H	讀/寫
	預留		1033H	5033H	
	O2LS：第二組輸出低點調整	0.0～100.0%	1034H	5034H	讀/寫
	O2HS：第二組輸出高點調整	0.0～100.0%	1035H	5035H	讀/寫
	預留		1036H	5036H	
	預留		1037H	5037H	
	預留		1038H	5038H	
	預留		1039H	5039H	

階層	項目	參數	RAM 地址	EEPROM 地址	讀寫
S P C 特 殊 功 能 階 層	BAUD：通訊速率設定	0=2400,1=4800,2=9600,3=19200,4=38400	103AH	503AH	讀/寫
	ADDR：通訊位址設定	0~127，0=不通訊	103BH	503BH	讀/寫
	S-BIT：通訊停止位元	0=1 位，1=2 位	103CH	503CH	讀/寫
	PARI：校驗位	0=無校驗，1=偶校驗，2=奇數同位檢查	103DH	503DH	讀/寫
	預留		103EH	503EH	
	PID-M：PID 切換模式	0=不切換，1=隨 SV 切換，2=隨 PV 切換	103FH	503FH	讀/寫
	AR-1：PID 切換區域 1	-199.9~999.9	1040H	5040H	讀/寫
	AR-2：PID 切換區域 2	-199.9~999.9	1041H	5041H	讀/寫
	AR-3：PID 切換區域 3	-199.9~999.9	1042H	5042H	讀/寫
	AR-4：PID 切換區域 4	-199.9~999.9	1043H	5043H	讀/寫
	AR-5：PID 切換區域 5	-199.9~999.9	1044H	5044H	讀/寫
	AR-6：PID 切換區域 6	-199.9~999.9	1045H	5045H	讀/寫
	AR-7：PID 切換區域 7	-199.9~999.9	1046H	5046H	讀/寫
	AR-DF：PID 切換回差	0~999.9	1047H	5047H	讀/寫
	預留		1048H	5048H	
	預留		1049H	5049H	

階層	項目	參數	RAM 地址	EEPROM 地址	讀寫
P I D 階 層 第 一 組	ID-P：積分微分時間小數點	0=無小數點，1=1 位小數	104AH	504AH	讀/寫
	P1：比例帶 1	0.1~999.9	104BH	504BH	讀/寫
	I1：積分時間 1	0~9999(ID-P=0)，0.0~999.9(ID-P=1)	104CH	504CH	讀/寫
	D1：微分時間 1	0~9999(ID-P=0)，0.0~999.9(ID-P=1)	104DH	504DH	讀/寫
	OL1：操作量下限 1	0.0~100.0%	104EH	504EH	讀/寫
	OH1：操作量上限 1	0.0~100.0%	104FH	504FH	讀/寫
	P1C：冷卻側比例帶 1	0.1~999.9	1050H	5050H	讀/寫
	I1C：冷卻側積分時間 1	0~9999(ID-P=0)，0.0~999.9(ID-P=1)	1051H	5051H	讀/寫
	D1C：冷卻側微分時間 1	0~9999(ID-P=0)，0.0~999.9(ID-P=1)	1052H	5052H	讀/寫
	OL1C：冷卻側操作量下限 1	0.0~100.0%	1053H	5053H	讀/寫
	OH1C：冷卻側操作量上限 1	0.0~100.0%	1054H	5054H	讀/寫
P I D 階 層 第 二 組	P2：比例帶 2	0.1~999.9	1055H	5055H	讀/寫
	I2：積分時間 2	0~9999(ID-P=0)，0.0~999.9(ID-P=1)	1056H	5056H	讀/寫
	D2：微分時間 2	0~9999(ID-P=0)，0.0~999.9(ID-P=1)	1057H	5057H	讀/寫
	OL2：操作量下限 2	0.0~100.0%	1058H	5058H	讀/寫
	OH2：操作量上限 2	0.0~100.0%	1059H	5059H	讀/寫
	P2C：冷卻側比例帶 2	0.1~999.9	105AH	505AH	讀/寫
	I2C：冷卻側積分時間 2	0~9999(ID-P=0)，0.0~999.9(ID-P=1)	105BH	505BH	讀/寫

組	D2C：冷卻側微分時間 2	0～9999(ID-P=0)，0.0～999.9(ID-P=1)	105CH	505CH	讀/寫
	OL2C：冷卻側操作量下限 2	0.0～100.0%	105DH	505DH	讀/寫
	OH2C：冷卻側操作量上限 2	0.0～100.0%	105EH	505EH	讀/寫
P I D 階 層 第 三 組	P3：比例帶 3	0.1～999.9	105FH	505FH	讀/寫
	I3：積分時間 3	0～9999(ID-P=0)，0.0～999.9(ID-P=1)	1060H	5060H	讀/寫
	D3：微分時間 3	0～9999(ID-P=0)，0.0～999.9(ID-P=1)	1061H	5061H	讀/寫
	OL3：操作量下限 3	0.0～100.0%	1062H	5062H	讀/寫
	OH3：操作量上限 3	0.0～100.0%	1063H	5063H	讀/寫
	P3C：冷卻側比例帶 3	0.1～999.9	1064H	5064H	讀/寫
	I3C：冷卻側積分時間 3	0～9999(ID-P=0)，0.0～999.9(ID-P=1)	1065H	5065H	讀/寫
	D3C：冷卻側微分時間 3	0～9999(ID-P=0)，0.0～999.9(ID-P=1)	1066H	5066H	讀/寫
	OL3C：冷卻側操作量下限 3	0.0～100.0%	1067H	5067H	讀/寫
	OH3C：冷卻側操作量上限 3	0.0～100.0%	1068H	5068H	讀/寫
P I D 階 層 第 四 組	P4：比例帶 4	0.1～999.9	1069H	5069H	讀/寫
	I4：積分時間 4	0～9999(ID-P=0)，0.0～999.9(ID-P=1)	106AH	506AH	讀/寫
	D4：微分時間 4	0～9999(ID-P=0)，0.0～999.9(ID-P=1)	106BH	506BH	讀/寫
	OL4：操作量下限 4	0.0～100.0%	106CH	506CH	讀/寫
	OH4：操作量上限 4	0.0～100.0%	106DH	506DH	讀/寫
	P4C：冷卻側比例帶 4	0.1～999.9	106EH	506EH	讀/寫
	I4C：冷卻側積分時間 4	0～9999(ID-P=0)，0.0～999.9(ID-P=1)	106FH	506FH	讀/寫
	D4C：冷卻側微分時間 4	0～9999(ID-P=0)，0.0～999.9(ID-P=1)	1070H	5070H	讀/寫
	OL4C：冷卻側操作量下限 4	0.0～100.0%	1071H	5071H	讀/寫
	OH4C：冷卻側操作量上限 4	0.0～100.0%	1072H	5072H	讀/寫
P I D 階 層 第 五 組	P5：比例帶 5	0.1～999.9	1073H	5073H	讀/寫
	I5：積分時間 5	0～9999(ID-P=0)，0.0～999.9(ID-P=1)	1074H	5074H	讀/寫
	D5：微分時間 5	0～9999(ID-P=0)，0.0～999.9(ID-P=1)	1075H	5075H	讀/寫
	OL5：操作量下限 5	0.0～100.0%	1076H	5076H	讀/寫
	OH5：操作量上限 5	0.0～100.0%	1077H	5077H	讀/寫
	P5C：冷卻側比例帶 5	0.1～999.9	1078H	5078H	讀/寫
	I5C：冷卻側積分時間 5	0～9999(ID-P=0)，0.0～999.9(ID-P=1)	1079H	5079H	讀/寫
	D5C：冷卻側微分時間 5	0～9999(ID-P=0)，0.0～999.9(ID-P=1)	107AH	507AH	讀/寫
	OL5C：冷卻側操作量下限 5	0.0～100.0%	107BH	507BH	讀/寫
	OH5C：冷卻側操作量上限 5	0.0～100.0%	107CH	507CH	讀/寫
P I D 階 層 第 六 組	P6：比例帶 6	0.1～999.9	107DH	507DH	讀/寫
	I6：積分時間 6	0～9999(ID-P=0)，0.0～999.9(ID-P=1)	107EH	507EH	讀/寫
	D6：微分時間 6	0～9999(ID-P=0)，0.0～999.9(ID-P=1)	107FH	507FH	讀/寫
	OL6：操作量下限 6	0.0～100.0%	1080H	5080H	讀/寫
	OH6：操作量上限 6	0.0～100.0%	1081H	5081H	讀/寫
	P6C：冷卻側比例帶 6	0.1～999.9	1082H	5082H	讀/寫
	I6C：冷卻側積分時間 6	0～9999(ID-P=0)，0.0～999.9(ID-P=1)	1083H	5083H	讀/寫

組	D6C：冷卻側微分時間 6	0～9999(ID-P=0)，0.0～999.9(ID-P=1)	1084H	5084H	讀/寫
	OL6C：冷卻側操作量下限 6	0.0～100.0%	1085H	5085H	讀/寫
	OH6C：冷卻側操作量上限 6	0.0～100.0%	1086H	5086H	讀/寫
P I D 階 層 第 七 組	P7：比例帶 7	0.1～999.9	1087H	5087H	讀/寫
	I7：積分時間 7	0～9999(ID-P=0)，0.0～999.9(ID-P=1)	1088H	5088H	讀/寫
	D7：微分時間 7	0～9999(ID-P=0)，0.0～999.9(ID-P=1)	1089H	5089H	讀/寫
	OL7：操作量下限 7	0.0～100.0%	108AH	508AH	讀/寫
	OH7：操作量上限 7	0.0～100.0%	108BH	508BH	讀/寫
	P7C：冷卻側比例帶 7	0.1～999.9	108CH	508CH	讀/寫
	I7C：冷卻側積分時間 7	0～9999(ID-P=0)，0.0～999.9(ID-P=1)	108DH	508DH	讀/寫
	D7C：冷卻側微分時間 7	0～9999(ID-P=0)，0.0～999.9(ID-P=1)	108EH	508EH	讀/寫
	OL7C：冷卻側操作量下限 7	0.0～100.0%	108FH	508FH	讀/寫
P I D 階 層 第 八 組	OH7C：冷卻側操作量上限 7	0.0～100.0%	1090H	5090H	讀/寫
	P8：比例帶 8	0.1～999.9	1091H	5091H	讀/寫
	I8：積分時間 8	0～9999(ID-P=0)，0.0～999.9(ID-P=1)	1092H	5092H	讀/寫
	D8：微分時間 8	0～9999(ID-P=0)，0.0～999.9(ID-P=1)	1093H	5093H	讀/寫
	OL8：操作量下限 8	0.0～100.0%	1094H	5094H	讀/寫
	OH8：操作量上限 8	0.0～100.0%	1095H	5095H	讀/寫
	P8C：冷卻側比例帶 8	0.1～999.9	1096H	5096H	讀/寫
	I8C：冷卻側積分時間 8	0～9999(ID-P=0)，0.0～999.9(ID-P=1)	1097H	5097H	讀/寫
	D8C：冷卻側微分時間 8	0～9999(ID-P=0)，0.0～999.9(ID-P=1)	1098H	5098H	讀/寫
	OL8C：冷卻側操作量下限 8	0.0～100.0%	1099H	5099H	讀/寫
	OH8C：冷卻側操作量上限 8	0.0～100.0%	109AH	509AH	讀/寫
	預留		109BH	509BH	
	預留		109CH	509CH	

階 層	項目	參數	RAM 地址	EEPROM 地址	讀寫
I	INP：輸入類型選擇	0～32	109DH	509DH	讀/寫

N P 輸 入 階 層	LOSP：設定值低點參照	參照表 1	109EH	509EH	讀/寫
	HISP：設定值高點參照	參照表 1	109FH	509FH	讀/寫
	LOAN：線性輸入低點對照	-1999～9999	10A0H	50A0H	讀/寫
	HIAN：線性輸入高點對照	-1999～9999	10A1H	50A1H	讀/寫
	A1LS：線性輸入低點調整	0～FFFFH	10A2H	50A2H	讀/寫
	A1HS：線性輸入高點調整	0～FFFFH	10A3H	50A3H	讀/寫
	UNIT：單位選擇	0=℃，1=°F	10A4H	50A4H	讀/寫
	DP：小數點設定	0=0000，1=000.0，2=00.00，3=0.000	10A5H	50A5H	讀/寫
	FILT：軟體濾波	0.001～1.000 (1.000=不濾波)	10A6H	50A6H	讀/寫
	PVOF：PV 偏差修正	-199.9～200.0 (PV+PVOF)	10A7H	50A7H	讀/寫
	PVRR：PV 斜率修正	0.001～9.999 (PV*PVRR)	10A8H	50A8H	讀/寫
	SVOF：SV 偏差修正	-199.9～200.0 (SV+SVOF)	10A9H	50A9H	讀/寫
	PV0P：第一段 PV 補償點	-199.9～999.9	10AAH	50AAH	讀/寫
	PV0T：第一段 PV 補償值	-199.9～200.0	10ABH	50ABH	讀/寫
	PV1P：第二段 PV 補償點	-199.9～999.9	10ACH	50ACH	讀/寫
	PV1T：第二段 PV 補償值	-199.9～200.0	10ADH	50ADH	讀/寫
	PV2P：第三段 PV 補償點	-199.9～999.9	10AEH	50AEH	讀/寫
	PV2T：第三段 PV 補償值	-199.9～200.0	10AFH	50AFH	讀/寫
	PV3P：第四段 PV 補償點	-199.9～999.9	10B0H	50B0H	讀/寫
	PV3T：第四段 PV 補償值	-199.9～200.0	10B1H	50B1H	讀/寫
	PV4P：第五段 PV 補償點	-199.9～999.9	10B2H	50B2H	讀/寫
	PV4T：第五段 PV 補償值	-199.9～200.0	10B3H	50B3H	讀/寫
	PV5P：第六段 PV 補償點	-199.9～999.9	10B4H	50B4H	讀/寫
	PV5T：第六段 PV 補償值	-199.9～200.0	10B5H	50B5H	讀/寫
	PV6P：第七段 PV 補償點	-199.9～999.9	10B6H	50B6H	讀/寫
	PV6T：第七段 PV 補償值	-199.9～200.0	10B7H	50B7H	讀/寫
	PV7P：第八段 PV 補償點	-199.9～999.9	10B8H	50B8H	讀/寫
	PV7T：第八段 PV 補償值	-199.9～200.0	10B9H	50B9H	讀/寫
	PV8P：第九段 PV 補償點	-199.9～999.9	10BAH	50BAH	讀/寫
	PV8T：第九段 PV 補償值	-199.9～200.0	10BBH	50BBH	讀/寫
	PV9P：第十段 PV 補償點	-199.9～999.9	10BCH	50BCH	讀/寫
	PV9T：第十段 PV 補償值	-199.9～200.0	10BDH	50BDH	讀/寫
	預留		10BEH	50BEH	
	預留		10BFH	50BFH	

階 層	項目	參數	RAM 地址	EEPROM 地址	讀寫
P	LINE：當前曲線組顯示	1～8 組	10C0H	50C0H	唯讀

R O G 程 式 控 制 功 能 階 層	SEG：當前曲線段顯示	1～8 段	10C1H	50C1H	唯讀
	TIME：程式段剩餘時間顯示	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	10C2H	50C2H	唯讀
	RPT：程式重複次數設定	1～1000	10C3H	50C3H	讀/寫
	STAT：程式啟動模式	0=禁用，1=手動，2=上電，3=掉電記憶處	10C4H	50C4H	讀/寫
	LNST：程式啟動曲線組選擇	1～8 組	10C5H	50C5H	讀/寫
	PVST：程式啟動點選擇	0=從 0 開始，1=從 PV 開始	10C6H	50C6H	讀/寫
	WAIT：程式等待溫度設定	0～200	10C7H	50C7H	讀/寫
	L1CN：曲線 1 末尾連接	0～8 組，0=程式結束	10C8H	50C8H	讀/寫
	L2CH：曲線 2 末尾連接	0～8 組，0=程式結束	10C9H	50C9H	讀/寫
	L3CN：曲線 3 末尾連接	0～8 組，0=程式結束	10CAH	50CAH	讀/寫
	L4CN：曲線 4 末尾連接	0～8 組，0=程式結束	10CBH	50CBH	讀/寫
	L5CN：曲線 5 末尾連接	0～8 組，0=程式結束	10CCH	50CCH	讀/寫
	L6CN：曲線 6 末尾連接	0～8 組，0=程式結束	10CDH	50CDH	讀/寫
	L7CN：曲線 7 末尾連接	0～8 組，0=程式結束	10CEH	50CEH	讀/寫
	L8CN：曲線 8 末尾連接	0～8 組，0=程式結束	10CFH	50CFH	讀/寫
	ENDS：曲線結束點	0～8 段，0=由曲線末尾連接決定	10D0H	50D0H	讀/寫
	CMD：程式控制命令接收	0x01：程式啟動、程式繼續 0x02：程式停止 0x03：跳轉下一曲線 0x04：跳轉下一段 0x05：程式暫停	10D1H	50D1H	只寫
	預留		10D2H	50D2H	

階 層	項目	參數	RAM 地址	EEPROM 地址	讀寫
L I N 1	SP1.1：第 1 段 SV 設定值	LOSP～HISP	1100H	5100H	讀/寫
	PG1.1：第 1 段 PID 組選擇	1～8	1101H	5101H	讀/寫
	TP1.1：第 1 段斜率時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	1102H	5102H	讀/寫
	TS1.1：第 1 段保持時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	1103H	5103H	讀/寫

第一組曲線參數	SP1.2：第 2 段 SV 設定值	LOSP～HISP	1104H	5104H	讀/寫
	PG1.2：第 2 段 PID 組選擇	1～8	1105H	5105H	讀/寫
	TP1.2：第 2 段斜率時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	1106H	5106H	讀/寫
	TS1.2：第 2 段保持時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	1107H	5107H	讀/寫
	SP1.3：第 3 段 SV 設定值	LOSP～HISP	1108H	5108H	讀/寫
	PG1.3：第 3 段 PID 組選擇	1～8	1109H	5109H	讀/寫
	TP1.3：第 3 段斜率時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	110AH	510AH	讀/寫
	TS1.3：第 3 段保持時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	110BH	510BH	讀/寫
	SP1.4：第 4 段 SV 設定值	LOSP～HISP	110CH	510CH	讀/寫
	PG1.4：第 4 段 PID 組選擇	1～8	110DH	510DH	讀/寫
	TP1.4：第 4 段斜率時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	110EH	510EH	讀/寫
	TS1.4：第 4 段保持時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	110FH	510FH	讀/寫
	SP1.5：第 5 段 SV 設定值	LOSP～HISP	1110H	5110H	讀/寫
	PG1.5：第 5 段 PID 組選擇	1～8	1111H	5111H	讀/寫
	TP1.5：第 5 段斜率時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	1112H	5112H	讀/寫
	TS1.5：第 5 段保持時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	1113H	5113H	讀/寫
	SP1.6：第 6 段 SV 設定值	LOSP～HISP	1114H	5114H	讀/寫
	PG1.6：第 6 段 PID 組選擇	1～8	1115H	5115H	讀/寫
	TP1.6：第 6 段斜率時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	1116H	5116H	讀/寫
	TS1.6：第 6 段保持時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	1117H	5117H	讀/寫
	SP1.7：第 7 段 SV 設定值	LOSP～HISP	1118H	5118H	讀/寫
	PG1.7：第 7 段 PID 組選擇	1～8	1119H	5119H	讀/寫
	TP1.7：第 7 段斜率時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	111AH	511AH	讀/寫
	TS1.7：第 7 段保持時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	111BH	511BH	讀/寫
	SP1.8：第 8 段 SV 設定值	LOSP～HISP	111CH	511CH	讀/寫
	PG1.8：第 8 段 PID 組選擇	1～8	111DH	511DH	讀/寫
	TP1.8：第 8 段斜率時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	111EH	511EH	讀/寫
	TS1.8：第 8 段保持時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	111FH	511FH	讀/寫

階層	項目	參數	RAM 地址	EEPROM 地址	讀寫
L I N	SP2.1：第 1 段 SV 設定值	LOSP～HISP	1120H	5120H	讀/寫
	PG2.1：第 1 段 PID 組選擇	1～8	1121H	5121H	讀/寫
	TP2.1：第 1 段斜率時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	1122H	5122H	讀/寫

2 第二組 曲線參數	TS2.1：第 1 段保持時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	1123H	5123H	讀/寫
	SP2.2：第 2 段 SV 設定值	LOSP～HISP	1124H	5124H	讀/寫
	PG2.2：第 2 段 PID 組選擇	1～8	1125H	5125H	讀/寫
	TP2.2：第 2 段斜率時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	1126H	5126H	讀/寫
	TS2.2：第 2 段保持時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	1127H	5127H	讀/寫
	SP2.3：第 3 段 SV 設定值	LOSP～HISP	1128H	5128H	讀/寫
	PG2.3：第 3 段 PID 組選擇	1～8	1129H	5129H	讀/寫
	TP2.3：第 3 段斜率時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	112AH	512AH	讀/寫
	TS2.3：第 3 段保持時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	112BH	512BH	讀/寫
	SP2.4：第 4 段 SV 設定值	LOSP～HISP	112CH	512CH	讀/寫
	PG2.4：第 4 段 PID 組選擇	1～8	112DH	512DH	讀/寫
	TP2.4：第 4 段斜率時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	112EH	512EH	讀/寫
	TS2.4：第 4 段保持時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	112FH	512FH	讀/寫
	SP2.5：第 5 段 SV 設定值	LOSP～HISP	1130H	5130H	讀/寫
	PG2.5：第 5 段 PID 組選擇	1～8	1131H	5131H	讀/寫
	TP2.5：第 5 段斜率時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	1132H	5132H	讀/寫
	TS2.5：第 5 段保持時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	1133H	5133H	讀/寫
	SP2.6：第 6 段 SV 設定值	LOSP～HISP	1134H	5134H	讀/寫
	PG2.6：第 6 段 PID 組選擇	1～8	1135H	5135H	讀/寫
	TP2.6：第 6 段斜率時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	1136H	5136H	讀/寫
	TS2.6：第 6 段保持時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	1137H	5137H	讀/寫
	SP2.7：第 7 段 SV 設定值	LOSP～HISP	1138H	5138H	讀/寫
	PG2.7：第 7 段 PID 組選擇	1～8	1139H	5139H	讀/寫
	TP2.7：第 7 段斜率時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	113AH	513AH	讀/寫
	TS2.7：第 7 段保持時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	113BH	513BH	讀/寫
	SP2.8：第 8 段 SV 設定值	LOSP～HISP	113CH	513CH	讀/寫
	PG2.8：第 8 段 PID 組選擇	1～8	113DH	513DH	讀/寫
	TP2.8：第 8 段斜率時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	113EH	513EH	讀/寫
	TS2.8：第 8 段保持時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	113FH	513FH	讀/寫

階層	項目	參數	RAM 地址	EEPROM 地址	讀寫
L I N 3	SP3.1：第 1 段 SV 設定值	LOSP～HISP	1140H	5140H	讀/寫
	PG3.1：第 1 段 PID 組選擇	1～8	1141H	5141H	讀/寫
	TP3.1：第 1 段斜率時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	1142H	5142H	讀/寫
	TS3.1：第 1 段保持時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	1143H	5143H	讀/寫

第三組曲線參數	SP3.2：第 2 段 SV 設定值	LOSP～HISP	1144H	5144H	讀/寫
	PG3.2：第 2 段 PID 組選擇	1～8	1145H	5145H	讀/寫
	TP3.2：第 2 段斜率時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	1146H	5146H	讀/寫
	TS3.2：第 2 段保持時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	1147H	5147H	讀/寫
	SP3.3：第 3 段 SV 設定值	LOSP～HISP	1148H	5148H	讀/寫
	PG3.3：第 3 段 PID 組選擇	1～8	1149H	5149H	讀/寫
	TP3.3：第 3 段斜率時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	114AH	514AH	讀/寫
	TS3.3：第 3 段保持時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	114BH	514BH	讀/寫
	SP3.4：第 4 段 SV 設定值	LOSP～HISP	114CH	514CH	讀/寫
	PG3.4：第 4 段 PID 組選擇	1～8	114DH	514DH	讀/寫
	TP3.4：第 4 段斜率時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	114EH	514EH	讀/寫
	TS3.4：第 4 段保持時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	114FH	514FH	讀/寫
	SP3.5：第 5 段 SV 設定值	LOSP～HISP	1150H	5150H	讀/寫
	PG3.5：第 5 段 PID 組選擇	1～8	1151H	5151H	讀/寫
	TP3.5：第 5 段斜率時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	1152H	5152H	讀/寫
	TS3.5：第 5 段保持時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	1153H	5153H	讀/寫
	SP3.6：第 6 段 SV 設定值	LOSP～HISP	1154H	5154H	讀/寫
	PG3.6：第 6 段 PID 組選擇	1～8	1155H	5155H	讀/寫
	TP3.6：第 6 段斜率時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	1156H	5156H	讀/寫
	TS3.6：第 6 段保持時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	1157H	5157H	讀/寫
	SP3.7：第 7 段 SV 設定值	LOSP～HISP	1158H	5158H	讀/寫
	PG3.7：第 7 段 PID 組選擇	1～8	1159H	5159H	讀/寫
	TP3.7：第 7 段斜率時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	115AH	515AH	讀/寫
	TS3.7：第 7 段保持時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	115BH	515BH	讀/寫
	SP3.8：第 8 段 SV 設定值	LOSP～HISP	115CH	515CH	讀/寫
	PG3.8：第 8 段 PID 組選擇	1～8	115DH	515DH	讀/寫
	TP3.8：第 8 段斜率時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	115EH	515EH	讀/寫
	TS3.8：第 8 段保持時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	115FH	515FH	讀/寫

階層	項目	參數	RAM 地址	EEPROM 地址	讀寫
L I N 4	SP4.1：第 1 段 SV 設定值	LOSP～HISP	1160H	5160H	讀/寫
	PG4.1：第 1 段 PID 組選擇	1～8	1161H	5161H	讀/寫
	TP4.1：第 1 段斜率時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	1162H	5162H	讀/寫
	TS4.1：第 1 段保持時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	1163H	5163H	讀/寫

第四組曲線參數	SP4.2：第 2 段 SV 設定值	LOSP～HISP	1164H	5164H	讀/寫
	PG4.2：第 2 段 PID 組選擇	1～8	1165H	5165H	讀/寫
	TP4.2：第 2 段斜率時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	1166H	5166H	讀/寫
	TS4.2：第 2 段保持時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	1167H	5167H	讀/寫
	SP4.3：第 3 段 SV 設定值	LOSP～HISP	1168H	5168H	讀/寫
	PG4.3：第 3 段 PID 組選擇	1～8	1169H	5169H	讀/寫
	TP4.3：第 3 段斜率時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	116AH	516AH	讀/寫
	TS4.3：第 3 段保持時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	116BH	516BH	讀/寫
	SP4.4：第 4 段 SV 設定值	LOSP～HISP	116CH	516CH	讀/寫
	PG4.4：第 4 段 PID 組選擇	1～8	116DH	516DH	讀/寫
	TP4.4：第 4 段斜率時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	116EH	516EH	讀/寫
	TS4.4：第 4 段保持時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	116FH	516FH	讀/寫
	SP4.5：第 5 段 SV 設定值	LOSP～HISP	1170H	5170H	讀/寫
	PG4.5：第 5 段 PID 組選擇	1～8	1171H	5171H	讀/寫
	TP4.5：第 5 段斜率時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	1172H	5172H	讀/寫
	TS4.5：第 5 段保持時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	1173H	5173H	讀/寫
	SP4.6：第 6 段 SV 設定值	LOSP～HISP	1174H	5174H	讀/寫
	PG4.6：第 6 段 PID 組選擇	1～8	1175H	5175H	讀/寫
	TP4.6：第 6 段斜率時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	1176H	5176H	讀/寫
	TS4.6：第 6 段保持時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	1177H	5177H	讀/寫
	SP4.7：第 7 段 SV 設定值	LOSP～HISP	1178H	5178H	讀/寫
	PG4.7：第 7 段 PID 組選擇	1～8	1179H	5179H	讀/寫
	TP4.7：第 7 段斜率時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	117AH	517AH	讀/寫
	TS4.7：第 7 段保持時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	117BH	517BH	讀/寫
	SP4.8：第 8 段 SV 設定值	LOSP～HISP	117CH	517CH	讀/寫
	PG4.8：第 8 段 PID 組選擇	1～8	117DH	517DH	讀/寫
	TP4.8：第 8 段斜率時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	117EH	517EH	讀/寫
	TS4.8：第 8 段保持時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	117FH	517FH	讀/寫

階層	項目	參數	RAM 地址	EEPROM 地址	讀寫
L I N 5	SP5.1：第 1 段 SV 設定值	LOSP～HISP	1180H	5180H	讀/寫
	PG5.1：第 1 段 PID 組選擇	1～8	1181H	5181H	讀/寫
	TP5.1：第 1 段斜率時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	1182H	5182H	讀/寫
	TS5.1：第 1 段保持時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	1183H	5183H	讀/寫

第五組曲線參數	SP5.2：第 2 段 SV 設定值	LOSP～HISP	1184H	5184H	讀/寫
	PG5.2：第 2 段 PID 組選擇	1～8	1185H	5185H	讀/寫
	TP5.2：第 2 段斜率時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	1186H	5186H	讀/寫
	TS5.2：第 2 段保持時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	1187H	5187H	讀/寫
	SP5.3：第 3 段 SV 設定值	LOSP～HISP	1188H	5188H	讀/寫
	PG5.3：第 3 段 PID 組選擇	1～8	1189H	5189H	讀/寫
	TP5.3：第 3 段斜率時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	118AH	518AH	讀/寫
	TS5.3：第 3 段保持時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	118BH	518BH	讀/寫
	SP5.4：第 4 段 SV 設定值	LOSP～HISP	118CH	518CH	讀/寫
	PG5.4：第 4 段 PID 組選擇	1～8	118DH	518DH	讀/寫
	TP5.4：第 4 段斜率時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	118EH	518EH	讀/寫
	TS5.4：第 4 段保持時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	118FH	518FH	讀/寫
	SP5.5：第 5 段 SV 設定值	LOSP～HISP	1190H	5190H	讀/寫
	PG5.5：第 5 段 PID 組選擇	1～8	1191H	5191H	讀/寫
	TP5.5：第 5 段斜率時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	1192H	5192H	讀/寫
	TS5.5：第 5 段保持時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	1193H	5193H	讀/寫
	SP5.6：第 6 段 SV 設定值	LOSP～HISP	1194H	5194H	讀/寫
	PG5.6：第 6 段 PID 組選擇	1～8	1195H	5195H	讀/寫
	TP5.6：第 6 段斜率時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	1196H	5196H	讀/寫
	TS5.6：第 6 段保持時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	1197H	5197H	讀/寫
	SP5.7：第 7 段 SV 設定值	LOSP～HISP	1198H	5198H	讀/寫
	PG5.7：第 7 段 PID 組選擇	1～8	1199H	5199H	讀/寫
	TP5.7：第 7 段斜率時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	119AH	519AH	讀/寫
	TS5.7：第 7 段保持時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	119BH	519BH	讀/寫
	SP5.8：第 8 段 SV 設定值	LOSP～HISP	119CH	519CH	讀/寫
	PG5.8：第 8 段 PID 組選擇	1～8	119DH	519DH	讀/寫
	TP5.8：第 8 段斜率時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	119EH	519EH	讀/寫
	TS5.8：第 8 段保持時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	119FH	519FH	讀/寫

階層	項目	參數	RAM 地址	EEPROM 地址	讀寫
L I N 6	SP6.1：第 1 段 SV 設定值	LOSP～HISP	11A0H	51A0H	讀/寫
	PG6.1：第 1 段 PID 組選擇	1～8	11A1H	51A1H	讀/寫
	TP6.1：第 1 段斜率時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	11A2H	51A2H	讀/寫
	TS6.1：第 1 段保持時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	11A3H	51A3H	讀/寫

第六組曲線參數	SP6.2：第 2 段 SV 設定值	LOSP～HISP	11A4H	51A4H	讀/寫
	PG6.2：第 2 段 PID 組選擇	1～8	11A5H	51A5H	讀/寫
	TP6.2：第 2 段斜率時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	11A6H	51A6H	讀/寫
	TS6.2：第 2 段保持時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	11A7H	51A7H	讀/寫
	SP6.3：第 3 段 SV 設定值	LOSP～HISP	11A8H	51A8H	讀/寫
	PG6.3：第 3 段 PID 組選擇	1～8	11A9H	51A9H	讀/寫
	TP6.3：第 3 段斜率時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	11AAH	51AAH	讀/寫
	TS6.3：第 3 段保持時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	11ABH	51ABH	讀/寫
	SP6.4：第 4 段 SV 設定值	LOSP～HISP	11ACH	51ACH	讀/寫
	PG6.4：第 4 段 PID 組選擇	1～8	11ADH	51ADH	讀/寫
	TP6.4：第 4 段斜率時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	11AEH	51AEH	讀/寫
	TS6.4：第 4 段保持時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	11AFH	51AFH	讀/寫
	SP6.5：第 5 段 SV 設定值	LOSP～HISP	11B0H	51B0H	讀/寫
	PG6.5：第 5 段 PID 組選擇	1～8	11B1H	51B1H	讀/寫
	TP6.5：第 5 段斜率時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	11B2H	51B2H	讀/寫
	TS6.5：第 5 段保持時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	11B3H	51B3H	讀/寫
	SP6.6：第 6 段 SV 設定值	LOSP～HISP	11B4H	51B4H	讀/寫
	PG6.6：第 6 段 PID 組選擇	1～8	11B5H	51B5H	讀/寫
	TP6.6：第 6 段斜率時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	11B6H	51B6H	讀/寫
	TS6.6：第 6 段保持時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	11B7H	51B7H	讀/寫
	SP6.7：第 7 段 SV 設定值	LOSP～HISP	11B8H	51B8H	讀/寫
	PG6.7：第 7 段 PID 組選擇	1～8	11B9H	51B9H	讀/寫
	TP6.7：第 7 段斜率時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	11BAH	51BAH	讀/寫
	TS6.7：第 7 段保持時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	11BBH	51BBH	讀/寫
	SP6.8：第 8 段 SV 設定值	LOSP～HISP	11BCH	51BCH	讀/寫
	PG6.8：第 8 段 PID 組選擇	1～8	11BDH	51BDH	讀/寫
	TP6.8：第 8 段斜率時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	11BEH	51BEH	讀/寫
	TS6.8：第 8 段保持時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	11BFH	51BFH	讀/寫

階層	項目	參數	RAM 地址	EEPROM 地址	讀寫
L I N 7	SP7.1：第 1 段 SV 設定值	LOSP～HISP	11C0H	51C0H	讀/寫
	PG7.1：第 1 段 PID 組選擇	1～8	11C1H	51C1H	讀/寫
	TP7.1：第 1 段斜率時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	11C2H	51C2H	讀/寫
	TS7.1：第 1 段保持時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	11C3H	51C3H	讀/寫

第七組曲線參數	SP7.2：第 2 段 SV 設定值	LOSP～HISP	11C4H	51C4H	讀/寫
	PG7.2：第 2 段 PID 組選擇	1～8	11C5H	51C5H	讀/寫
	TP7.2：第 2 段斜率時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	11C6H	51C6H	讀/寫
	TS7.2：第 2 段保持時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	11C7H	51C7H	讀/寫
	SP7.3：第 3 段 SV 設定值	LOSP～HISP	11C8H	51C8H	讀/寫
	PG7.3：第 3 段 PID 組選擇	1～8	11C9H	51C9H	讀/寫
	TP7.3：第 3 段斜率時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	11CAH	51CAH	讀/寫
	TS7.3：第 3 段保持時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	11CBH	51CBH	讀/寫
	SP7.4：第 4 段 SV 設定值	LOSP～HISP	11CCH	51CCH	讀/寫
	PG7.4：第 4 段 PID 組選擇	1～8	11CDH	51CDH	讀/寫
	TP7.4：第 4 段斜率時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	11CEH	51CEH	讀/寫
	TS7.4：第 4 段保持時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	11CFH	51CFH	讀/寫
	SP7.5：第 5 段 SV 設定值	LOSP～HISP	11D0H	51D0H	讀/寫
	PG7.5：第 5 段 PID 組選擇	1～8	11D1H	51D1H	讀/寫
	TP7.5：第 5 段斜率時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	11D2H	51D2H	讀/寫
	TS7.5：第 5 段保持時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	11D3H	51D3H	讀/寫
	SP7.6：第 6 段 SV 設定值	LOSP～HISP	11D4H	51D4H	讀/寫
	PG7.6：第 6 段 PID 組選擇	1～8	11D5H	51D5H	讀/寫
	TP7.6：第 6 段斜率時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	11D6H	51D6H	讀/寫
	TS7.6：第 6 段保持時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	11D7H	51D7H	讀/寫
	SP7.7：第 7 段 SV 設定值	LOSP～HISP	11D8H	51D8H	讀/寫
	PG7.7：第 7 段 PID 組選擇	1～8	11D9H	51D9H	讀/寫
	TP7.7：第 7 段斜率時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	11DAH	51DAH	讀/寫
	TS7.7：第 7 段保持時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	11DBH	51DBH	讀/寫
	SP7.8：第 8 段 SV 設定值	LOSP～HISP	11DCH	51DCH	讀/寫
	PG7.8：第 8 段 PID 組選擇	1～8	11DDH	51DDH	讀/寫
	TP7.8：第 8 段斜率時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	11DEH	51DEH	讀/寫
	TS7.8：第 8 段保持時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	11DFH	51DFH	讀/寫

階層	項目	參數	RAM 地址	EEPROM 地址	讀寫
L I N 8	SP8.1：第 1 段 SV 設定值	LOSP～HISP	11E0H	51E0H	讀/寫
	PG8.1：第 1 段 PID 組選擇	1～8	11E1H	51E1H	讀/寫
	TP8.1：第 1 段斜率時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	11E2H	51E2H	讀/寫
	TS8.1：第 1 段保持時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	11E3H	51E3H	讀/寫

第八組 曲線參數	SP8.2：第 2 段 SV 設定值	LOSP～HISP	11E4H	51E4H	讀/寫
	PG8.2：第 2 段 PID 組選擇	1～8	11E5H	51E5H	讀/寫
	TP8.2：第 2 段斜率時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	11E6H	51E6H	讀/寫
	TS8.2：第 2 段保持時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	11E7H	51E7H	讀/寫
	SP8.3：第 3 段 SV 設定值	LOSP～HISP	11E8H	51E8H	讀/寫
	PG8.3：第 3 段 PID 組選擇	1～8	11E9H	51E9H	讀/寫
	TP8.3：第 3 段斜率時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	11EAH	51EAH	讀/寫
	TS8.3：第 3 段保持時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	11EBH	51EBH	讀/寫
	SP8.4：第 4 段 SV 設定值	LOSP～HISP	11ECH	51ECH	讀/寫
	PG8.4：第 4 段 PID 組選擇	1～8	11EDH	51EDH	讀/寫
	TP8.4：第 4 段斜率時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	11EEH	51EEH	讀/寫
	TS8.4：第 4 段保持時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	11EFH	51EFH	讀/寫
	SP8.5：第 5 段 SV 設定值	LOSP～HISP	11F0H	51F0H	讀/寫
	PG8.5：第 5 段 PID 組選擇	1～8	11F1H	51F1H	讀/寫
	TP8.5：第 5 段斜率時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	11F2H	51F2H	讀/寫
	TS8.5：第 5 段保持時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	11F3H	51F3H	讀/寫
	SP8.6：第 6 段 SV 設定值	LOSP～HISP	11F4H	51F4H	讀/寫
	PG8.6：第 6 段 PID 組選擇	1～8	11F5H	51F5H	讀/寫
	TP8.6：第 6 段斜率時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	11F6H	51F6H	讀/寫
	TS8.6：第 6 段保持時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	11F7H	51F7H	讀/寫
	SP8.7：第 7 段 SV 設定值	LOSP～HISP	11F8H	51F8H	讀/寫
	PG8.7：第 7 段 PID 組選擇	1～8	11F9H	51F9H	讀/寫
	TP8.7：第 7 段斜率時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	11FAH	51FAH	讀/寫
	TS8.7：第 7 段保持時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	11FBH	51FBH	讀/寫
	SP8.8：第 8 段 SV 設定值	LOSP～HISP	11FCH	51FCH	讀/寫
	PG8.8：第 8 段 PID 組選擇	1～8	11FDH	51FDH	讀/寫
	TP8.8：第 8 段斜率時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	11FEH	51FEH	讀/寫
	TS8.8：第 8 段保持時間	00.00～99.59(時.分) (高位元組.低位元組)	11FFH	51FFH	讀/寫